

製品概要

FCH040N65S3: NチャンネルSuperFET® III MOSFET

技術情報は、データシートをご参照ください。

SuperFET® III MOSFETは、オンセミコンダクターの新しい高電圧スーパージャンクション(SJ)MOSFETファミリーです。非常に低いオン抵抗と低ゲートチャージ性能のための電荷バランス技術を採用しています。この高度な技術は導電損失を最小限に抑え、優れたスイッチング性能を提供し、極端なdv/dtレートに耐えるように設計されています。そのためSuperFET III MOSFETは、小型化と高効率が必要なさまざまな電源システムに最適です。

特長

- 700 V @ $T_J = 150^\circ\text{C}$
- 低ゲート電荷 (通常 $Q_g = 136 \text{ nC}$)
- 低実効出力キャパシタンス (通常 $C_{oss}(\text{eff.}) = 1154 \text{ pF}$)
- Optimized Capacitance
- 通常 $R_{DS}(\text{on}) = 35.4 \text{ m}\Omega$
- 100%電子なだれテスト済み
- RoHS に対応

アプリケーション

- Telecommunication
- Cloud system
- Industrial

利点

- Higher system reliability at low temperature operation
- Lower switching loss
- Lower switching loss
- Lower peak Vds and lower Vgs oscillation

最終製品

- Telecom power
- Server power
- EV charger
- Solar / UPS

電気的仕様

製品	Pricing (\$/Unit)	Compliance	Status	Channel Polarity	Configuration	$V_{DS}^{(BR)}$ Min (V)	V_{GS}^{Max} (V)	$V_{GS}^{(th)}$ Max (V)	I_D^{Max} (A)	P_D^{Max} (W)	$R_{DS(on)}^{n) Max @ V_{GS} = 2.5 \text{ V}}$ (m Ω)	$R_{DS(on)}^{n) Max @ V_{GS} = 4.5 \text{ V}}$ (m Ω)	$R_{DS(on)}^{n) Max @ V_{GS} = 10 \text{ V}}$ (m Ω)	$Q_g^{Typ @ V_{GS} = 4.5 \text{ V}}$ (nC)	$Q_g^{Typ @ V_{GS} = 10 \text{ V}}$ (nC)	C_{iss}^{Typ} (pF)	Package Type
FCH040N65S3-F155	4.1027	Pb-free	Active	N-Channel		650	± 30	4.5	65	417	-	-	40	-	136	4740	TO-247-3

詳細は、弊社 www.onsemi.jp の営業または販売代理店にお問い合わせください。

8/8/2020 作成